

News Release / Presseinformation

Infineon präsentiert die fünfte Generation thinQ!TM SiC Schottky-Dioden mit marktführender Effizienz zu einem attraktivem Preis-Leistungsverhältnis

Neubiberg, 26. September, 2012 – Mit der fünften Generation der 650V thinQ!TM SiC Schottky-Dioden erweitert Infineon Technologies die Palette seiner Produkte auf Siliziumkarbid-Basis (SiC).

Der Infineon-eigene Diffusionslötprozess, der bereits seit der Generation 3 angewandt wird, ist nun kombiniert mit einem kompakteren Design und den jüngsten Fortschritten im Bereich der Dünnwafertechnologie. Dies führt zu verbesserten thermischen Eigenschaften und einem um 30 Prozent geringeren FOM-(Figure-of-Merit-)Faktor ($Q_c \times V_f$) gegenüber früheren SiC-Dioden von Infineon.

Das Ergebnis ist eine Produktserie, die im Vergleich zu früheren thinQ!TM Generationen höhere Effizienz über alle Lastbereiche in PFC- und Boost-Topologien ermöglicht. Die Chips der fünften Generation sind für den Einsatz in High-End-Servern, Schaltnetzteilen in Telekommunikationsanlagen, PC-Netzteilen, Beleuchtungsanwendungen, Solarwechselrichtern und UPS-System (Uninterruptible Power Supply; unterbrechungsfreie Stromversorgung) optimiert. Diese Anwendungen profitieren von der verbesserten Effizienz, geringeren elektromagnetischen Interferenzen, größerer Zuverlässigkeit des Gesamtsystems und reduzierten Kühlkosten.

„Seit der Einführung der ersten SiC-Schottky-Dioden im Jahr 2001 hat Infineon seine Produktpalette kontinuierlich verbessert und erweitert. SiC-Dioden heben uns vom Wettbewerb ab und sind ein maßgeblicher Treiber auf dem Weg zu grüner Energie“, sagt Jan-Willem Reynaerts, Leiter des Produktbereichs High Voltage Power Conversion bei Infineon Technologies. „Die fünfte Generation ermöglicht weitere Verbesserungen in den Bereichen Systemeffizienz und Leistungsdichte, und das zu einem attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Mit den niedrigen kapazitiven Ladungswerten (Q_c) der dritten Generation und dem Durchlassspannungslevel (V_f) der zweiten ermöglicht die neuste Variante höchste Effizienzgrade in PFC-Schaltungen. Die neue Produktfamilie hat eine höheres

Durchschlagsspannungslevel: 650V gegenüber 600V in der zweiten und dritten Generation, passend zu den neusten Versionen der CoolMOS™ Technologie. Diese Eigenschaft erlaubt höhere Sicherheitsbereiche in Anwendungen wie Solarwechselrichtern und für Schaltnetzteile in anspruchsvollen Umgebungen. Darüber hinaus ist die fünfte Generation besonders robust gegen Stoßströme und bietet ein breiteres Portfolio, welches Produkte mit höheren Nennströmen und neuen Packages wie TO-247 und ThinPAK umfasst.

Verfügbarkeit

Muster sind ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen über die neuen 650V thinQ!™ SiC Schottky-Dioden der fünften Generation sind erhältlich unter www.infineon.com/sic-gen5

Über Infineon

Die [Infineon](http://www.infineon.com) Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: [Energieeffizienz](#), [Mobilität](#) sowie [Sicherheit](#). Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse.